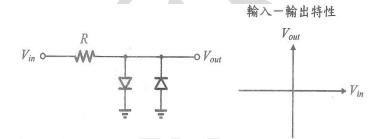
106 年特種考試地方政府公務人員考試試題

等 別:三等考試 類 科:電力工程 科 目:電子學

- 一、下左圖為電和二極體(Diode)所組成的電路,其中 $R=1k\Omega$ 。二極體電流 $I_D=I_Se^{V_D/V_T}$,其中 VD 為其導通電壓,IS 為飽和電流(saturation current)和 VT=25mV;當二極體電流 ID=1mA 時,其 VD=0.7V。
 - (一)當輸出電壓 V_{out} =-0.8、-0.7V、-0.5V、0V、0.5V、0.7V 和 0.8V 時,所對應的輸入電 V_{in} 為何?(15 分)
 - □請畫出此電路的輸入—輸出特性(如下右圖所示)。(5分)(按:請清楚作圖並標示數值。)



【擬答】:

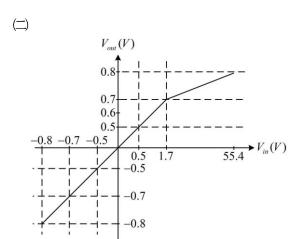
(-)

$$V_{D}^{'} - V_{D} = V_{T} \ln \frac{I_{D}^{'}}{I_{D}} \Rightarrow I_{D}^{'} = I_{D} e^{\frac{V_{D}^{'} - V_{D}}{V_{T}}} = 1m \cdot e^{\frac{V_{D}^{'} - 0.7}{25m}}$$

且

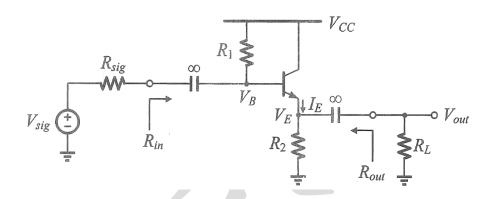
$$V_{in} = I_{\mathrm{D}}^{'} \times 1k + V_{out}$$

$V_{D}^{'}=V_{out}(V)$	$I_{D}^{'}(mA)$	$V_{in}(V)$
-0.8	8.76×10^{-27}	-0.8
-0.7	4.78×10 ⁻²⁵	-0.7
-0.5	1.43×10 ⁻²¹	-0.5
0	6.91×10 ⁻¹³	0
0.5	3.35×10^{-4}	0.5
0.7	1	1.7
0.8	54.6	55.4



共5頁 第1頁

- 二、對於下圖之射極隨耦器(Emitter follower)電路,其中所使用 BJT 電晶體的特性為 β =50、 V_T =25mV 和 $V_{BE(ON)}$ =0.7V,以及 V_{CC} =5V、 R_{sig} =1k Ω 、 R_1 =10k Ω 、 R_2 =2k Ω 和 R_L =2k Ω 。 (一)計算 I_E 、 V_E 及 V_B 。(10 分)
 - 二請利用小訊號分析,求出 R_{in}、Ro_{ut} 及 V_{out}/V_{sig}(10 分)



【擬答】:

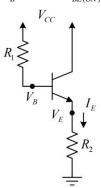
(-)

DC 分析

$$I_{E} = \frac{V_{CC} - 0.7}{\frac{R_{1}}{1 + \beta} + R_{2}} = 1.96mA$$

$$V_E = I_E R_2 = 3.92V$$

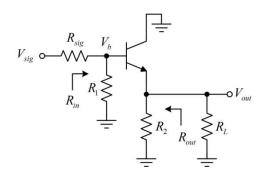
$$V_B = 3.92 + V_{BE(ON)} = 4.62V$$





$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25m}{1.96m} = 12.76\Omega = 0.01276k\Omega$$

ac 分析



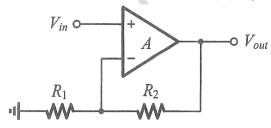
$$R_{in} = R_1 / (1 + \beta)[r_e + (R_2 / /R_L)]$$

$$= 10 / / (1 + 50)[0.01276 + (2 / /2)] = 8.38k\Omega$$

$$R_{out} = \left[\frac{R_{sig} / / R_1}{1 + \beta} + r_e\right] / / R_2 = \left[\frac{1 / / 10}{1 + 50} + 0.01276\right] / / 2 = 0.03k\Omega$$

$$\frac{V_{out}}{V_{sip}} = \frac{V_{out}}{V_b} \times \frac{V_b}{V_{sip}} = \frac{R_2 / / R_L}{r_e + (R_2 / / R_L)} \times \frac{R_{in}}{R_{sip} + R_{in}} = \frac{2 / / 2}{0.01276 + (2 / / 2)} \times \frac{8.38}{1 + 8.38} = 0.88$$

- 三、如下圖,利用運算放大器(Operational Amplifier)設計電路,使得整體電路增益可達到 10 的需求, 其中 R_1 = $1k\Omega$ 。
 - (一)假設使用理想運算放大器,求出 R2 的值。(10 分)
 - □接續(一),當運算放大器的增益 A 為有限值,但希望下圖電路的增益可以達到 0.1%誤差內,則運算放大器的增益 A 至少要多少才可以達到如此精準需求。(10 分)



【擬答】:

$$(-)$$

$$V_{out} = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_{in}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow 10 = 1 + \frac{R_2}{1} \Rightarrow R_2 = 9k\Omega$$



 (\Box)

$$V_{+} = V_{in}$$

$$V_{-} = V_{out} \frac{R_{1}}{R_{1} + R_{2}}$$

$$V_{out} = A(V_{+} - V_{-}) =$$

$$V_{out} = A(V_{+} - V_{-}) = A(V_{in} - V_{out} \frac{R_{1}}{R_{1} + R_{2}}) = AV_{in} - V_{out} \frac{R_{1}}{R_{1} + R_{2}} A$$

$$V_{out} + V_{out} \frac{R_1}{R_1 + R_2} A = AV_{in}$$

$$\Rightarrow (1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} A) V_{out} = A V_{in}$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2}A}$$

$$\because \frac{V_{out}}{V_{in}}\big|_{A \neq \infty} \ge 0.999 \frac{V_{out}}{V_{in}}\big|_{A = \infty}$$

$$\frac{A}{1+\frac{1}{1+9}A} \ge 0.999 \times 10$$

$$\Rightarrow \frac{A}{1 + \frac{A}{10}} \ge 9.99$$

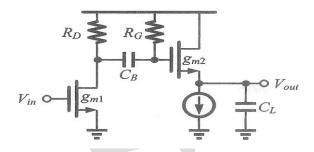
$$\Rightarrow A \ge 9990$$

四、忽略電晶體的通道調變效應(channel-length modulation effect),gm 為電晶體的轉導 (tuansconductance)。如下電路的頻率響應(frequency response)為 $A_v(S)=V_{out}(S)/V_{in}(S)$,包括中頻增益 A_M 以及點 ω_L 和 ω_H ,亦即可以表示為

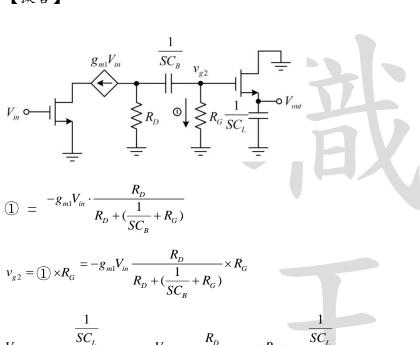
$$A_{v}(S) = -A_{M} \left(\frac{s}{s + \omega L} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{s}{\omega H}} \right)$$

請求出上式的中頻增益 A_M 以及極點ω_L和ω_H。(20 分)

【請以 $g_{m1} \cdot g_{m2} \cdot R_D \cdot R_G \cdot C_B$ 和 C_L 表示】



【擬答】:



$$V_{out} = v_{g2} - \frac{\frac{1}{SC_L}}{\frac{1}{g_{m2} + \frac{1}{SC_L}}} = -g_{m1}V_{in} - \frac{R_D}{R_D + \frac{1}{SC_B} + R_G} \times R_G \times \frac{\frac{1}{SC_L}}{\frac{1}{g_{m2}} + \frac{1}{SC_L}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} \times \frac{R_D R_G}{R_D + R_G} \times \frac{S}{S + \frac{1}{(R_D + R_G)C_B}} \times \frac{1}{1 + \frac{S}{g_{m2}}}$$

$$\therefore A_{M} = -g_{m1} \times \frac{R_{D}R_{G}}{R_{D} + R_{G}}$$

$$\omega_L = \frac{1}{(R_D + R_G)C_B}$$

$$\omega_H = \frac{g_{m2}}{C_L}$$

- 五、如下 CMOS 數位邏輯電路,其中 A、B、C和 D 為輸入,F 為輸出。
 - (-)由已知 NMOS 電路,完成方塊電路內所要 PMOS 對偶電路設計。 $(10\ \mathcal{G})$ 【請標清 V_{DD} 、A、B、C、D 和 F 等連接點】
 - 二請說明此 CMOS 數位路所執行的邏輯功能,以布林(Boolean)數學式表示。

